# ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT HAVING LAYER CONTAINING CONDUCTIVE HIGHPOLYMER

Publication number: JP2003257676 (A)

Publication date:

2003-09-12

Inventor(s):

ARAI KAZUMI +

Applicant(s):

FUJI PHOTO FILM CO LTD +

Classification:

- international:

C08G61/12; H01L51/50; H05B33/14; H05B33/26; C08G61/00; H01L51/50;

H05B33/14; H05B33/26; (IPC1-7): C08G61/12; H05B33/14; H05B33/26

- European:

Application number: JP20020370084 20021220

Priority number(s): JP20020370084 20021220; JP20010393758 20011226

# Abstract of JP 2003257676 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electroluminescence element to make light emission at a high light emission efficiency and capable of being driven at a low voltage, in particular even in the blue region, emitting the light at a high light emission efficiency, and having a high durability even when light emission is made with a high brightness.; SOLUTION: The organic electroluminescence element includes a light emitting layer formed between an anode and cathode through an evaporation process, wherein the light emitting layer has an adjoining layer containing at least one sort of light emitting material which makes light emission in the triplet excited condition and located adjacent to at least either of the anode side and cathode side of the light emitting layer, and the adjoining layer contains a conductive highpolymer.; COPYRIGHT: (C)2003,JPO

Data supplied from the *espacenet* database — Worldwide

# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-257676 (P2003-257676A)

(43)公開日 平成15年9月12日(2003.9.12)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
H05B	33/26	H05B	33/26 A	3 K 0 0 7
C 0 8 G	61/12	C 0 8 G	61/12	4J032
H05B	33/14	H05B	33/14 A	

# 審査請求 未請求 請求項の数10 〇L (全 25 頁)

(21)出願番号	特願2002-370084(P2002-370084)	(71)出願人 000005201
		富士写真フイルム株式会社
(22)出願日	平成14年12月20日(2002, 12, 20)	神奈川県南足柄市中沼210番地
		(72)発明者 新居 一巳
(31)優先権主張番号	特願2001-393758(P2001-393758)	神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真
(32)優先日	平成13年12月26日(2001, 12, 26)	フイルム株式会社内
(33)優先権主張国	日本(JP)	(74)代理人 100105647
(00) 逐少以前工工以中国	H4 (31)	
		弁理士 小栗 昌平 (外4名)
		Fターム(参考) 3K007 AB02 AB03 AB06 CC00 DB03
		FAO1
		4,1032 BA03 BA04 BA13 BD02 CA03
		CA12 CA14 CF02 CG01
		Sitta offia of oa odol

# (54) 【発明の名称】 導電性高分子を含有する層を有する有機電界発光素子

#### (57)【要約】

【課題】高い発光効率での発光、低電圧駆動が可能で、特に青色領域でも高い発光効率で発光し、高輝度発光時にも高い耐久性を有する有機電界発光素子を提供する。 【解決手段】陽極及び陰極の間に、蒸着により形成された発光層を有し、発光層は三重項励起状態から発光する発光材料を少なくとも1種含有し、発光層の陽極側及び陰極側の少なくとも一方に隣接する隣接層を有し、隣接層は導電性高分子を含有する有機電界発光素子。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 陽極及び陰極の間に、蒸着により形成された発光層を有し、

発光層は三重項励起状態から発光する発光材料を少なくとも1種含有し、発光層の陽極側及び陰極側の少なくとも一方に隣接する隣接層を有し、隣接層は導電性高分子を含有することを特徴とする有機電界発光素子。

【請求項2】 発光材料の最低励起三重項エネルギー準位が63kcal/mol以上81kcal/mol以下であることを特徴とする請求項1に記載の有機電界発光素子。

【請求項3】 発光材料の燐光の量子収率が0.5以上であることを特徴とする請求項1又は2に記載の有機電界発光素子。

【請求項4】 発光材料を除いた発光層の最低励起三重項エネルギー準位が64kcal/mol以上82kcal/mol以下であることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【請求項5】 隣接層の電気伝導度が $10^{-6}$ S·cm $^{-1}$ 以上であることを特徴とする請求項 $1\sim 4$ のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【請求項6】 導電性高分子が、芳香族炭素環または芳香族へテロ環を二価以上の連結基で連結した非共役高分子または共役高分子であることを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【請求項7】 導電性高分子がドーパントをドープされた共役高分子であることを特徴とする請求項1~6のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【請求項8】 導電性高分子が下記一般式(I)で表される部分構造を有することを特徴とする請求項1~7のいずれかに記載の有機電界発光素子。

# 一般式(I)

#### 【化1】

式中、 $R^{11}$ は置換基を表し、 $m^{11}$ は0ないし2の整数を表す。 $m^{11}$ が2を表すとき、複数の $R^{11}$ は互いに同一であっても異なってもよく、互いに連結して環を形成してもよい。 $n^{11}$ は1以上の整数を表す。

【請求項9】 導電性高分子が下記一般式(II)で表される部分構造を有することを特徴とする請求項1~6のいずれかに記載の有機電界発光素子。一般式(II) 【化2】

式中、 $L^{21}$ 、 $L^{22}$ は2 価の連結基を表す。 $R^{21}$ 、 $R^{22}$ 、 $R^{23}$ は置換基を表し、 $m^{21}$ 、 $m^{22}$ は0 ないし4 の整数を表し、 $m^{23}$ は0 ないし5 の整数を表す。 $m^{21}$  、 $m^{22}$ が2 ないし4 の整数を、 $m^{23}$  が2 ないし5 の整数を表すとき、複数の $R^{21}$ 、 $R^{22}$ 、 $R^{23}$ は、それぞれ、互いに同一であっても異なってもよく、互いに連結して環を形成してもよい。 $n^{21}$ は1 以上の整数を表す。

【請求項10】 導電性高分子が下記一般式(III)で表される部分構造を有することを特徴とする請求項1~6のいずれかに記載の有機電界発光素子。

#### 一般式(III)

#### 【化3】

$$\begin{array}{c|c}
 & \left( L^{31} \right)_{n^{31}} \\
 & \left( R^{33} \right)_{m^{33}} \\
 & \left( R^{32} \right)_{m^{32}} \\
 & \left( R^{32} \right)_{m^{32}}
\end{array}$$

式中、 $L^{31}$ は3価の連結基、 $L^{32}$ は単結合または2価の連結基を表す。 $R^{31}$ 、 $R^{32}$ 、 $R^{33}$ は置換基を表し、 $m^{31}$ は0ないし4の整数を表し、 $m^{32}$ 、 $m^{33}$ は0ないし5の整数を表す。 $m^{31}$ が2ないし4の整数を、 $m^{32}$ 、 $m^{33}$ が2ないし5の整数を表すとき、複数の $R^{31}$ 、 $R^{32}$ 、 $R^{33}$ は、それぞれ、互いに同一であっても異なってもよく、互いに連結して環を形成してもよい。 $n^{31}$ は1以上の整数を表す。

#### 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、バックライト、フラットパネルディスプレイ、照明光源、表示素子、電子写真、有機半導体レーザー、記録光源、露光光源、読み取り光源、標識、看板、光通信デバイスなどの分野に利用可能な有機電界発光素子に関するものである。

# [0002]

【従来の技術】今日、多様な発光素子の研究開発が活発に行われているが、その中で有機電界発光(EL)素子は、超薄型・軽量性、高速応答性、広視野角性、低電圧駆動などの特長を有しており、有望な発光素子として注目されている。一般に有機EL素子は、発光層及び該層を挟んだ一対の対向電極から構成されており、陰極から注入された電子と陽極から注入された正孔が再結合し、生成した励起子からの発光を利用するものである。

【0003】現在、低電圧で高輝度に発光する有機EL 素子としては、Tangらによって示された積層構造を 有するものが知られている(非特許文献1参照)。この 素子は、電子輸送材料と発光材料とを兼ねた材料と、ホ ール輸送材料とを積層することにより、高輝度の緑色発 光を得ており、6~7 Vの直流電圧で、輝度は数千 c d /m<sup>2</sup>に達している。しかしながら実用的な素子を考え た場合、更なる高輝度、高効率発光素子の開発が望まれ ている。最近、更に高効率に発光可能な素子として、イ リジウムのオルトメタル化錯体 (Ir (ppy) a: tris-or thoiridated complex with 2-Phenylpyridine) を発光 材料として用いた発光素子が報告された(非特許文献2 参照)。この発光素子は三重項励起子からの燐光発光を 利用したものであり、その外部量子効率 (発光効率) は 8.3%で、従来、限界といわれていた外部量子効率5 %を超えるものであり、優れている。通常、蛍光発光に 寄与する一重項励起子と燐光発光に寄与する三重項励起 子との比率は、1:3であり、三重項励起子を利用する ことで発光効率を向上することができる。しかしなが ら、前記イリジウムのオルトメタル化錯体は、緑色発光 素子に限定されているため、フルカラーディスプレイや 白色発光素子に応用する場合には、その他の色、特に青 色についても高効率に発光する素子の開発が必要であ る。

【0004】上記のイリジウムのオルトメタル化錯体の ような三重項励起子を利用する発光素子においては、発 光層中のホスト材料の最低励起三重項エネルギー準位が 発光材料より低いと、素子の発光効率が低下してしまう ので、ホスト材料の最低励起三重項エネルギー準位は発 光材料のそれより高くしなければならない。特に、三重 項励起子を利用する発光素子が色純度に優れた青色発光 する場合、発光材料の発光スペクトルは短波になる、つ まり該発光材料の最低励起三重項エネルギー準位が高く なる。そして、発光材料の最低励起三重項エネルギー準 位が高くなるに伴い、ホスト材料の最低励起三重項エネ ルギー準位も高くする必要がある。ホスト材料の最低励 起三重項エネルギー準位が高くなると電荷注入性が低下 してしまい、電荷注入性を維持しようとすると駆動電圧 が高くなり、素子の耐久性を落としてしまいかねない。 したがって、三重項励起子を利用する発光素子において 高効率発光を達成するためには、ホスト材料に電荷を効 率よく注入する方法の開発が望まれていた。また、高効 率発光には発光層の隣接する層の最低励起三重項エネル ギー準位も重要と考えられ、隣接する層の最低励起三重 項エネルギー準位が発光材料の最低励起三重項エネルギ 一準位より低い場合、ホスト材料中で生成した三重項励 起子が発光材料にエネルギー移動するのではなく、隣接 する層にエネルギー移動し、発光効率が低下してしまう ことがあり、隣接する層が発光材料へのエネルギー移動 を妨げないような素子の開発が望まれていた。さらに、

高輝度発光時の耐久性に優れた素子の開発が望まれていた。

# [0005]

【非特許文献1】アプライド フィジックス レターズ (Applied Physics Letters)、1987年、51巻、913頁

【非特許文献2】アプライド フィジックス レターズ (Applied Physics Letters)、1999年、75巻、4頁

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記諸問題に鑑み、高い発光効率で発光し、低電圧駆動が可能な有機電界発光素子、特に青色領域でも高い発光効率で発光する有機電界発光素子を提供することを課題とする。また、高輝度発光時にも高い耐久性を有する有機電界発光素子を提供することも課題とする。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、三重項青 色発光素子を高効率発光させる手法を鋭意検討した結 果、導電性高分子を蒸着型発光層に隣接させることによ り、高効率な青色発光を実現できることを見出した。す なわち、上記課題は下記手段によって達成される。

(1) 陽極及び陰極の間に、蒸着により形成された発 光層を有し、発光層は三重項励起状態から発光する発光 材料を少なくとも1種含有し、発光層の陽極側及び陰極 側の少なくとも一方に隣接する隣接層を有し、隣接層は 導電性高分子を含有することを特徴とする有機電界発光 素子。

【0008】(2) 発光材料の最低励起三重項エネルギー準位が63kcal/mol以上81kcal/mol以下であることを特徴とする上記(1)に記載の有機電界発光素子。

- (3) 発光材料の燐光の量子収率が0.5以上であることを特徴とする上記(1)又は(2)に記載の有機電界発光素子。
- (4) 発光材料を除いた発光層の最低励起三重項エネルギー準位が  $6.4 \text{ kcal/mol以} + 8.2 \text{ kcal/mol以} + 7.0 \text{ kcal/mol以} + 7.0 \text{ kcal/moly} + 7.0 \text{ kca$

【0009】(5) 隣接層の電気伝導度が $10^{-6}$ S·c  $m^1$ 以上であることを特徴とする上記(1) $\sim$ (4)のいずれかに記載の有機電界発光素子。

- (6) 導電性高分子が、芳香族炭素環または芳香族へ テロ環を二価以上の連結基で連結した非共役高分子また は共役高分子であることを特徴とする上記(1)~
- (5)のいずれかに記載の有機電界発光素子。
- (7) 導電性高分子がドーパントをドープされた共役高分子であることを特徴とする上記(1) $\sim$ (6)のいずれかに記載の有機電界発光素子。
- (8) 導電性高分子が下記一般式(I)で表される部

分構造を有することを特徴とする上記(1)~(7)のいずれかに記載の有機電界発光素子。一般式(I)

[0010]

【化4】

【0011】式中、 $R^{11}$ は置換基を表し、 $m^{11}$ は0ないし2の整数を表す。 $m^{11}$ が2を表すとき、複数の $R^{11}$ は互いに同一であっても異なってもよく、互いに連結して環を形成してもよい。 $n^{11}$ は1以上の整数を表す。

【0012】(9) 導電性高分子が下記一般式(II)で表される部分構造を有することを特徴とする上記(1)~(6)のいずれかに記載の有機電界発光素子。一般式(II)

[0013]

【化5】

$$-\left(L^{21}\right)_{m^{21}} + \left(R^{22}\right)_{m^{22}} - L^{22}$$

$$-\left(R^{23}\right)_{m^{23}} + L^{22}$$

$$-\left(R^{23}\right)_{m^{23}} + L^{22}$$

【0014】式中、 $L^{21}$ 、 $L^{22}$ は2価の連結基を表す。  $R^{21}$ 、 $R^{22}$ 、 $R^{23}$ は置換基を表し、 $m^{21}$ 、 $m^{22}$ は0ないし4の整数を表し、 $m^{23}$ は0ないし5の整数を表す。 $m^{21}$ 、 $m^{22}$ が2ないし4の整数を、 $m^{23}$ が2ないし5の整数を表すとき、複数の $R^{21}$ 、 $R^{22}$ 、 $R^{23}$ は、それぞれ、互いに同一であっても異なってもよく、互いに連結して環を形成してもよい。 $n^{21}$ は1以上の整数を表す。

【0015】(10) 導電性高分子が下記一般式(III)で表される部分構造を有することを特徴とする上記(1)~(6)のいずれかに記載の有機電界発光素子。一般式(III)

[0016]

【化6】

【0017】式中、 $L^{31}$ は3価の連結基、 $L^{32}$ は単結合または2価の連結基を表す。 $R^{31}$ 、 $R^{32}$ 、 $R^{33}$ は置換基を表し、 $m^{31}$ は0ないし4の整数を表し、 $m^{32}$ 、 $m^{33}$ は

0ないし5の整数を表す。 $m^{31}$ が2ないし4の整数を、 $m^{32}$ 、 $m^{33}$ が2ないし5の整数を表すとき、複数の  $R^{31}$ 、 $R^{32}$ 、 $R^{33}$ は、それぞれ、互いに同一であっても 異なってもよく、互いに連結して環を形成してもよい。  $n^{31}$ は1以上の整数を表す。

#### [0018]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明する。本発明の有機電界発光素子は、一対の電極間に少なくとも1層の発光層を有する有機電界発光素子であって、発光層の隣接層は導電性高分子を含有し、かつ発光層が蒸着法により製膜され、三重項励起状態から発光する発光材料を少なくとも1種含有することを特徴とする。隣接層は発光層に対して陽極側又は陰極側の両方に有することが可能であるが、陽極側に有することが好ましい。この場合、有機電界発光素子の最小の層構成は、陽極/隣接層/発光層/陰極(/:界面)である。所望する機能や性質に応じてこれ以外にも、ホール注入層、ホール輸送層、電子注入層、電子輸送層、保護層などを有してもよく、またこれらの各層はそれぞれ他の機能を備えたものであってもよいし、隣接層がこれら各層の機能を備えたものであってもよい。

【0019】隣接層の電気伝導度(単位:S・cm<sup>-1</sup>)は、10<sup>-6</sup>S・cm<sup>-1</sup>以上とするのが好ましく、10<sup>-3</sup>S・cm<sup>-1</sup>以上がより好ましく、10<sup>-1</sup>S・cm<sup>-1</sup>以上が特に好ましい。隣接層の電気伝導度が高いほど、発光層への電荷注入輸送性が上がり発光効率を高めることができる。また素子の駆動電圧を抑えるのにも効果がある。本発明では、隣接層を設けることで、電極と発光層との間に準位が生じるため、発光層への電荷注入が行なわれやすくなる。ここで準位とはイオン化ポテンシャル又は電子親和力をさす。

【0020】本発明で隣接層に含有される導電性高分子 は、好ましくは芳香族炭素環または芳香族ヘテロ環を単 結合または二価以上の連結基で連結した非共役高分子ま たは共役高分子である。ここで、芳香族炭素環として は、例えばベンゼン環が挙げられ、更に縮環を形成して もよい。また、芳香族ヘテロ環としては例えばピリジン 環、ビラジン環、ピリミジン環、ピリダジン環、トリア ジン環、オキサゾール環、チアゾール環、イミダゾール 環、オキサジアゾール環、チアジアゾール環、トリアゾ ール環、テトラゾール環、フラン環、チオフェン環、ピ ロール環、インドール環、カルバゾール環、ペンゾイミ ダゾール環、イミダゾピリジン環などが挙げられ、更に 縮環を形成してもよく、置換基を有してもよい。また、 芳香族炭素環または芳香族へテロ環を連結する二価以上 の連結基としては、単結合、炭素原子、珪素原子、窒素 原子、硼素原子、酸素原子、硫黄原子、金属、金属イオ ンなどで形成される連結基が挙げられる。好ましくは単 結合、炭素原子、窒素原子、珪素原子、硼素原子、酸素 原子、硫黄原子およびこれらの組み合わせから形成され る基であり、組み合わせにより形成される基としては、 置換もしくは無置換のメチレン基、カルボニル基、イミ ノ基、スルホニル基、スルフィニル基、エステル基、ア ミド基、シリル基などが挙げられる。

【0021】導電性高分子としては、発光層への電荷注 入性を良くし発光効率を上げる観点から、共役高分子で あることが更に好ましい。共役高分子の例としては、ポ リアセチレン、ポリジアセチレン、ポリ (パラフェニレ ン)、ポリフルオレン、ポリアズレン、ポリ(パラフェ ニレンサルファイド)、ポリピロール、ポリチオフェ ン、ポリイソチアナフテン、ポリアニリン、ポリ(パラ フェニレンビニレン)、ポリ(2,5ーチエニレンビニ レン)、複鎖型共役系高分子(ポリペリナフタレンな ど)、金属フタロシアニン系高分子、その他共役系高分 子 (ポリ (パラキシリレン)、ポリ [ $\alpha$  - (5, 5'-ビチオフェンジイル) ベンジリデン] など) が挙げられ る。好ましくはポリ(パラフェニレン)、ポリピロー ル、ポリチオフェン、ポリアニリン、ポリ (パラフェニ レンビニレン)、ポリ(2,5-チエニレンビニレンが 挙げられ、より好ましくはポリ(パラフェニレン)、ポ リチオフェン、ポリ (パラフェニレンビニレン) などが 挙げられる。共役系高分子として特に好ましくは、上記 一般式(I)で表される部分構造を有する導電性高分子 である。上記一般式(I)中、R11は置換基を表し、m 11は0ないし2の整数を表す。m11が2を表すとき、複 数のR11は、互いに同一であっても異なっても良く、互 いに連結して環を形成してもよい。

【0022】R11が表す置換基としては、アルキル基 (好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1 ~12、特に好ましくは炭素数1~8であり、例えばメ チル、エチル、iso-プロピル、tert-ブチル、 n-オクチル、n-デシル、n-ヘキサデシル、シクロ プロピル、シクロペンチル、シクロヘキシルなどが挙げ られる。)、アルケニル基(好ましくは炭素数2~2 0、より好ましくは炭素数2~12、特に好ましくは炭 素数2~8であり、例えばビニル、アリル、2-ブテニ ル、3-ペンテニル、2-ヘキセニル、3-ヘキセニ ル、4-ヘキセニル、2-オクテニルなどが挙げられ る。)、アルキニル基(好ましくは炭素数2~20、よ り好ましくは炭素数2~12、特に好ましくは炭素数2 ~8であり、例えばプロパルギル、3-ペンチニルなど が挙げられる。)、アリール基(好ましくは炭素数6~ 30、より好ましくは炭素数6~20、特に好ましくは 炭素数6~12であり、例えばフェニル、pーメチルフ ェニル、ナフチルなどが挙げられる。)、アミノ基(好 ましくは炭素数0~20、より好ましくは炭素数0~1 ○、特に好ましくは炭素数○~6であり、例えばアミ ノ、メチルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ、 ジベンジルアミノ、ジフェニルアミノなどが挙げられ る。)、

【0023】アルコキシ基(好ましくは炭素数1~2 ○、より好ましくは炭素数1~12、特に好ましくは炭 素数1~8であり、例えばメトキシ、エトキシ、ブトキ シ、ヘキシルオキシ、オクチルオキシなどが挙げられ る。)、アリールオキシ基(好ましくは炭素数6~2 ○、より好ましくは炭素数6~16、特に好ましくは炭 素数 $6\sim1$ 2であり、例えばフェニルオキシ、2-ナフ チルオキシなどが挙げられる。)、アシル基(好ましく は炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特 に好ましくは炭素数1~12であり、例えばアセチル、 ベンゾイル、ホルミル、ピバロイルなどが挙げられ る。)、アルコキシカルボニル基(好ましくは炭素数2 ~20、より好ましくは炭素数2~16、特に好ましく は炭素数2~12であり、例えばメトキシカルボニル、 エトキシカルボニルなどが挙げられる。)、アリールオ キシカルボニル基(好ましくは炭素数7~20、より好 ましくは炭素数7~16、特に好ましくは炭素数7~1 0であり、例えばフェニルオキシカルボニルなどが挙げ られる。)、

【0024】アシルオキシ基(好ましくは炭素数2~2 0、より好ましくは炭素数2~16、特に好ましくは炭 素数2~10であり、例えばアセトキシ、ベンゾイルオ キシなどが挙げられる。)、アシルアミノ基(好ましく は炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~16、特 に好ましくは炭素数2~10であり、例えばアセチルア ミノ、ベンゾイルアミノなどが挙げられる。)、アルコ キシカルボニルアミノ基(好ましくは炭素数2~20、 より好ましくは炭素数2~16、特に好ましくは炭素数 2~12であり、例えばメトキシカルボニルアミノなど が挙げられる。)、アリールオキシカルボニルアミノ基 (好ましくは炭素数7~20、より好ましくは炭素数7  $\sim 16$ 、特に好ましくは炭素数 $7\sim 12$ であり、例えば フェニルオキシカルボニルアミノなどが挙げられ る。)、スルホニルアミノ基(好ましくは炭素数1~2 ○、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭 素数1~12であり、例えばメタンスルホニルアミノ、 ベンゼンスルホニルアミノなどが挙げられる。)、スル

【0025】カルバモイル基(好ましくは炭素数 $1\sim2$ 0、より好ましくは炭素数 $1\sim16$ 、特に好ましくは炭素数 $1\sim12$ であり、例えばカルバモイル、メチルカルバモイル、ジエチルカルバモイル、フェニルカルバモイルなどが挙げられる。)、アルキルチオ基(好ましくは炭素数 $1\sim20$ 、より好ましくは炭素数 $1\sim16$ 、特に好ましくは炭素数 $1\sim16$ 、特に好ましくは炭素数 $1\sim12$ であり、例えばメチルチオ、エチルチオなどが挙げられる。)、アリールチオ基(好

ファモイル基(好ましくは炭素数0~20、より好まし

くは炭素数 $0\sim16$ 、特に好ましくは炭素数 $0\sim12$ で

あり、例えばスルファモイル、メチルスルファモイル、

ジメチルスルファモイル、フェニルスルファモイルなど

が挙げられる。)、

ましくは炭素数6~20、より好ましくは炭素数6~1 6、特に好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェ ニルチオなどが挙げられる。)、スルホニル基(好まし くは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、 特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばメシル、 トシルなどが挙げられる。)、スルフィニル基(好まし くは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、 特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばメタンス ルフィニル、ベンゼンスルフィニルなどが挙げられ る。)、ウレイド基(好ましくは炭素数1~20、より 好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~ 12であり、例えばウレイド、メチルウレイド、フェニ ルウレイドなどが挙げられる。)、リン酸アミド基(好 ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~1 6、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばジエ チルリン酸アミド、フェニルリン酸アミドなどが挙げら れる。)、

【0026】ヒドロキシ基、メルカプト基、ハロゲン原 子(例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原 子)、シアノ基、スルホ基、カルボキシル基、ニトロ 基、ヒドロキサム酸基、スルフィノ基、ヒドラジノ基、 イミノ基、ヘテロ環基(好ましくは炭素数1~20、よ り好ましくは炭素数1~12で、ヘテロ原子としては、 例えば窒素原子、酸素原子、硫黄原子が挙げられる。具 体的には、例えばピロリジン、ピペリジン、ピペラジ ン、モルフォリン、チオフェン、フラン、ピロール、イ ミダゾール、ピラゾール、ピリジン、ピラジン、ピリダ ジン、トリアゾール、トリアジン、インドール、インダ ゾール、プリン、チアゾリン、チアゾール、チアジアゾ ール、オキサゾリン、オキサゾール、オキサジアゾー ル、キノリン、イソキノリン、フタラジン、ナフチリジ ン、キノキサリン、キナゾリン、シンノリン、プテリジ ン、アクリジン、フェナントロリン、フェナジン、テト ラゾール、ベンズイミダゾール、ベンズオキサゾール、

ベンズチアゾール、ベンゾトリアゾール、テトラザイン デンなどが挙げられる。)、シリル基(好ましくは炭素数3~40、より好ましくは3~30、特に好ましくは3~24であり、例えばトリメチルシリル、トリフェニルシリルなどが挙げられる。)などが挙げられる。

【0027】上記置換基は、さらに置換されていてもよい。また、置換基を複数有する場合、それらの置換基は互いに同じでも異なっていてもよく、また可能な場合は連結して環を形成してもよい。形成される環としては例えば、ベンゼン環、チオフェン環、ジオキサン環、ジチアン環等が挙げられる。

【0028】R11が表す置換基として、好ましくはアル キル基、アルケニル基、アルキニル基、アルコキシ基、 アルキルチオ基であり、さらに好ましくはアルキル基、 アルコキシ基、アルキルチオ基である。特に好ましく は、m<sup>11</sup>が2のとき、2つのR<sup>11</sup>が環を形成したアルコ キシ基、アルキルチオ基であり、例えば、ジオキサン 環、ジチアン環等が挙げられる。m<sup>11</sup>が1のとき、R<sup>11</sup> はアルキル基である(炭素数2~8のアルキル基が好ま しい)。また、 $R^{11}$ が、アルキル基であるポリ(3-ア ルキルチオフェン)であるとき、隣り合ったチオフェン 環との連結様式はすべて2-5′で連結した立体規則的 なものと、2-2′、5-5′連結が含まれる立体不規 則的なものがあるが、立体的不規則なものが好ましい。 【0029】上記一般式(I)中、n11は、好ましくは 10~1000、より好ましくは50~5000、特 に好ましくは50~1000の整数である。

【0030】以下に、共役系高分子の具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。また、これらの他にも、W098/01909記載の化合物等が挙げられる。

[0031]

【化7】

$$(1) \qquad (2) \qquad C_{9}H_{5} \qquad (3)$$

$$-C_{4}H_{9} - n \qquad (4)$$

$$-C_{9}H_{13} \qquad (5) \qquad -C_{9}H_{17} - n \qquad (6) \qquad (7)$$

$$-C_{9}H_{13} \qquad -C_{17}C_{18} \qquad -C_{2}H_{5} \qquad (6) \qquad (7)$$

$$-C_{2}H_{5} \qquad -C_{2}H_{5} \qquad -C_{2}H_{5} \qquad -C_{2}H_{5} \qquad -C_{2}H_{6} - n$$

$$-C_{2}H_{5} \qquad -C_{2}H_{5} \qquad -C_{2}H_{5} \qquad -C_{2}H_{5} - n$$

$$-C_{2}H_{5} \qquad -C_{4}H_{9} - n \qquad -C_{2}H_{5} \qquad -C_{4}H_{9} - n$$

$$-C_{2}H_{5} \qquad -C_{4}H_{9} - n \qquad -C_{2}H_{5} \qquad -C_{4}H_{9} - n$$

$$-C_{2}H_{5} \qquad -C_{4}H_{9} - n \qquad -C_{4}H_{5} - n \qquad -C_{4}H_{5} - n$$

$$-C_{2}H_{5} \qquad -C_{4}H_{5} - n \qquad -C_{4}$$

[0032]

【0033】非共役高分子としては、上記一般式(II) または上記一般式(III)で表される部分構造を有する 導電性高分子が好ましい。上記一般式(II)または上記 一般式 (III) 中、R<sup>21</sup>、R<sup>22</sup>、R<sup>23</sup>、R<sup>31</sup>、R<sup>32</sup>、R 33は置換基を表し、該置換基は上記一般式(I)中のR 11と同義である。m<sup>21</sup>、m<sup>22</sup>、m<sup>31</sup>はOないし4の整数 を表し、m<sup>23</sup>、m<sup>32</sup>、m<sup>33</sup>はOないし5の整数である。 m21が2以上の整数を表すとき、複数のR21は、互いに 同じであっても異なってもよく、互いに連結して環を形 成してもよい (m<sup>22</sup>、m<sup>23</sup>、m<sup>31</sup>、m<sup>32</sup>、m<sup>33</sup>が2以上 の整数を表すとき存在する複数のR<sup>22</sup>、R<sup>23</sup>、R<sup>31</sup>、R 32、R33についても同様である)。形成する環は好まし くは、芳香族炭素環または芳香環へテロ環である。 L<sup>21</sup>、L<sup>22</sup>、L<sup>32</sup>は2価の連結基、L<sup>31</sup>は3価の連結基 であり、芳香族炭素環、芳香族ヘテロ環、炭素原子、窒 素原子、珪素原子、硼素原子、酸素原子および硫黄原 子、またはこれらの組み合わせから形成される基であ り、組み合わせから形成される基としては、置換または 無置換のメチレン基、芳香族炭素環基、カルボニル基、 イミノ基、スルホニル基、スルフィニル基、エステル 基、アミド基などが挙げられる。

【0034】一般式 (II) において、 $R^{21}$ 、 $R^{22}$ 、 $R^{23}$  は好ましくはアルキル基、アルコキシ基、アリール基であり、より好ましくは、アルキル基、アリール基である。 $m^{21}$ 、 $m^{22}$ 、 $m^{23}$ が2以上の整数を表すとき、複数の $R^{21}$ 、 $R^{22}$ 、 $R^{23}$ は、それぞれ、互いに連結して環を形成してもよく、形成される環は好ましくは、芳香族炭素環、芳香族へテロ環などが挙げられる。 $R^{23}$ は特に好ましくはジアリールアミノ基を置換基として有する芳香族炭素環である。 $L^{21}$ 、 $L^{22}$ は好ましくは置換または無

置換のメチレン基、カルボニル基、スルホニル基、スルフィニル基、エステル基、芳香族炭素環、シリル基またはこれらの組み合わせからなる基である。

【0035】一般式 (III) において、 $R^{31}$ 、 $R^{32}$ 、 $R^{33}$ は好ましくはアルキル基、アルコキシ基、アリール基であり、より好ましくは、アルキル基、アリール基である。 $m^{31}$ 、 $m^{32}$ 、 $m^{33}$ が2以上の整数を表すとき、複数の $R^{31}$ 、 $R^{32}$ 、 $R^{33}$ は、それぞれ、互いに連結して環を形成してもよく、形成される環は好ましくは、芳香族炭素環、芳香族へテロ環などが挙げられる。 $R^{33}$ は特に好ましくはジアリールアミノ基を置換基として有する芳香族炭素環である。 $L^{21}$ 、 $L^{22}$ は好ましくは置換または無置換のメチレン基、カルボニル基、スルホニル基、スルフィニル基、エステル基、芳香族炭素環、シリル基またはこれらの組み合わせからなる基である。

【0036】 $n^{21}$ 、 $n^{31}$ は好ましくは $5\sim5000$ 、より好ましくは $20\sim2000$ 、特に好ましくは $20\sim1000$ の整数である。

【0037】以下に、非共役系高分子の具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。また、これらの他にも、特許第310989号、特開平7-188398号、特開平8-188773号、特開平8-269446号、特開平8-295880号、特開2000-80167号、特開2000-150169号、特開2001-208087号、特開2002-75654号、特開2002-117982号、特開2002-117983号、特表2002-506481号などに記載の化合物などが挙げられる。

[0038]

【化9】

$$(A-1)$$

$$(A-1$$

$$(A-2)$$

$$(A-2)$$

$$(A-2)$$

$$(A-1)$$

$$(A-2)$$

$$(A-1)$$

$$(A-2)$$

$$(A-2$$

$$\underbrace{\left\langle \left\langle \right\rangle - \left\langle \right\rangle \right\rangle}_{CH_3}$$

[0039]

【化10】

$$(A-5)$$

$$+O \longrightarrow N \longrightarrow O \longrightarrow SO_2 \longrightarrow X$$

$$(A-6)$$

$$+O \longrightarrow N \longrightarrow O \longrightarrow CO \longrightarrow X$$

$$C_2H_5 \qquad C_2H_5$$

$$(A-7)$$

$$\left(O \longrightarrow N \longrightarrow O \longrightarrow C \xrightarrow{C} C \xrightarrow{C} X \xrightarrow{C}$$

$$(A-8)$$

$$C_4H_9-n$$

[0040]

【化11】

(A-11) 
$$CH_3$$
  $CH_3$   $C(CH_2)_{6 \times x}$ 

【0042】本発明で用いる導電性高分子の重量平均分子量は、 $1000\sim1000000$ が好ましく、より好ましくは $10000\sim500000$ であり、さらに好ましくは $10000\sim10000$ である。

【0043】隣接層の電気伝導度を上げ、更に発光層への電荷注入性を改善し発光効率を上げる観点から、導電性高分子は、少なくとも一種のドーパントを含有していることが好ましく、前記共役高分子にドーパントを含有させたものであることがより好ましい。導電性高分子に含有されるドーパントとしては、電子受容性(アクセプター)ドーパント、電子供与性(ドナー)ドーパントが挙げられる。

- ,  $AsF_6^-$  ,  $SbF_6^-$  ,  $BF_4^-$  , 各種スルホン酸アニオン)、その他( $O_2$  ,  $XeOF_4$  ,  $(NO_2^+)$  ( $SbF_6^-$ ) , ( $NO_2^+$ ) ( $SbF_6^-$ ) , ( $NO_2^+$ ) ( $SbF_4^-$ ) ,  $FSO_2OOSO_2F$  ,  $AgC1O_4$  ,  $H_2I$  rCl<sub>6</sub> , La ( $NO_3$ )  $_3$  ·  $6H_2O$ 等が挙げられる。

【 O O A f J 電子供与性(ドナー)ドーパントの例としてはアルカリ金属(Li , Na , K , Rb , Cs ) 、アルカリ土類金属(Ca , Sr , Ba ) 、ランタノイド(Euなど)、その他( $R_4$   $N^+$  ,  $R_4$   $P^+$  ,  $R_4$   $As^+$  ,  $R_3$   $S^+$  , アセチルコリン)等が挙げられる。

【0046】ドーパントと前記共役高分子材料との組み合わせとしては、例えば、ポリアセチレンと  $I_2$ , As  $F_5$ ,  $FeCI_3$ など、ポリ (p-7) カントと  $I_2$ , As  $F_5$ ,  $FeCI_3$ など、ポリ (p-7) カントロソニウン  $I_2$  カントロソニウム塩、アースチレンスルホン酸、ニトロソニウム塩、アースカム塩、キノン類など、ポリイソチアナフテンと  $I_2$ など、ポリ (p-7) カントロンナルファイド)と  $I_2$  など、ポリ (p-7) カントロンナルントンと  $I_3$  など、ポリ (p-7) カントロンと  $I_4$  など、ポリ (p-7) カントロンと  $I_5$  など、ポリチオフェニレンビニレンと  $I_5$  など、ニッケルフタロシアニンと  $I_5$  など、等が挙げられる。

【0047】また、導電性高分子は高分子鎖に電解質をドープしたイオン導電性高分子であってもよく、高分子鎖の例としては、ポリエーテル(ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシドなど)、ポリエステル(ポリエチレンサクシネート、ポリ $-\beta-$ プロピオラクトンなど)、ポリアミン(ポリエチレンイミンなど)、ポリスルフィド(ポリアルキレンスルフィドなど)などが挙げられ、ドープされた電解質としては各種アルカリ金属塩などが挙げられる。

【0049】高分子鎖とアルカリ金属塩の組み合わせとしては例えばポリエチレンオキシドとLiCF $_3$ SO $_3$ 、LiClO $_4$ など、ポリエチレンサクシネートとLiClO $_4$ 、には $_4$ 、ポリー $_6$  -プロピオラクトンとLiClO $_4$ など、ポリエチレンイミンとNaCF $_3$ SO $_3$ 、LiBF $_4$ など、ポリアルキレンスルフィドとAgNO $_3$ などが挙げられる。

【0050】本発明の有機電界発光素子において、隣接層は発光素子の耐久性向上の観点から、塗布により製膜されることが好ましい。また、大面積に一度に塗布ができるというような素子作製の簡便性の観点からも、塗布による製膜は好ましい。このため、隣接層に含有される導電性高分子は、有機溶剤で塗布できるものが特に好ましい。

【0051】次に発光層を形成する材料について説明する。本発明の素子に含有される発光材料は、自らが発光素子の発光に寄与するものであり、少なくとも1種は三

重項励起状態から発光する三重項発光材料である。三重 項発光材料としては、常温で三重項励起状態から発光す るものが好ましく、重原子を含有する芳香族炭素環ない し芳香族へテロ環など、より好ましくは、芳香族炭素環 ないし芳香族へテロ環を配位子として持つ遷移金属錯体 などが挙げられる。

【0052】遷移金属錯体を構成する遷移金属原子とし ては特に限定しないが、好ましくは、ルテニウム、ロジ ウム、パラジウム、タングステン、レニウム、イリジウ ム、白金であり、より好ましくはルテニウム、レニウ ム、イリジウム、白金である。遷移金属錯体の配位子と しては例えば、G.Wilkinson等著、「Comprehensive Coor dination Chemistry」Pergamon Press社 1987年発 行、 H.Yersin著「Photochemistry and Photophysics o f Coordination Compounds」 Springer-Verlag社 19 87年発行、山本明夫著「有機金属化学-基礎と応用 - 」 裳華房社 1982年発行 等に記載の配位子が挙 げられ、好ましくは、ハロゲン配位子(好ましくは塩素 配位子)、含窒素ヘテロ環配位子(例えばフェニルピリ ジン、ベンゾキノリン、キノリノール、ビピリジル、フ ェナントロリンなど)、ジケトン配位子(例えばアセチ ルアセトンなど)、カルボン酸配位子(例えば酢酸配位 子など)、一酸化炭素配位子、イソニトリル配位子、シ アノ配位子である。

【0053】遷移金属錯体としては、オルトメタル化金属錯体が好ましい。オルトメタル化金属錯体とは、例えば「有機金属化学-基礎と応用-」 p150,232 裳華房社 山本明夫著 1982年発行、「Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds」 p71-77, p135-146 Springer-Verlag社 H. Yersin著1987年発行等に記載されている化合物群の総称である。特に好ましくはオルトメタル化イリジウム錯体(orthometalated Ir Complexes)からなる発光素子材料である。

【0054】オルトメタル化イリジウム錯体のイリジウ ムの価数は特に限定しないが、3価が好ましい。オルト メタル化イリジウム錯体の配位子は、オルトメタル化錯 体を形成し得るものであれば特に問わないが、例えば、 アリール基置換含窒素へテロ環誘導体(アリール基の置 換位置は含窒素へテロ環窒素原子の隣接炭素上であり、 アリール基としては例えばフェニル基、ナフチル基、ア ントリル基、フェナントリル基、ピレニル基などが挙げ られ、さらに炭素環、ヘテロ環と縮環を形成してもよ い。含窒素へテロ環としては、例えば、ピリジン、ピリ ミジン、ピラジン、ピリダジン、キノリン、イソキノリ ン、キノキサリン、フタラジン、キナゾリン、ナフチリ ジン、シンノリン、ペリミジン、フェナントロリン、ピ ロール、イミダゾール、ピラゾール、オキサゾール、オ キサジアゾール、トリアゾール、チアジアゾール、ベン ズイミダゾール、ベンズオキサゾール、ベンズチアゾー ル、フェナントリジンなどが挙げられる)、ヘテロアリ

ール基置換含窒素へテロ環誘導体(ヘテロアリール基の 置換位置は含窒素ヘテロ環窒素原子の隣接炭素上であ る。ヘテロアリール基としては、例えば前記の含窒素へ テロ環誘導体を含有する基、チエニル基、フリル基など が挙げられる)、7、8-ベンゾキノリン、ホスフィノ アリール、ホスフィノヘテロアリール、ホスフィノキシ アリール、ホスフィノキシヘテロアリール、アミノメチ ルアリール、アミノメチルヘテロアリールおよびこれら の誘導体等が挙げられる。好ましくは、アリール基置換 含窒素芳香族へテロ環、ヘテロアリール基置換含窒素芳 香族へテロ環、7,8-ベンゾキノリンおよびこれらの 誘導体であり、フェニルピリジン、チエニルピリジン、 7,8-ベンゾキノリン、ベンジルピリジン、フェニル ピラゾール、フェニルイソキノリン、窒素原子を2つ以 上有するアゾールのフェニル置換体及びこれらの誘導体 がさらに好ましく、電子吸引性基(例えば、ハロゲン原 子、シアノ基、アゾール基)を持つアリール基が置換し た芳香族へテロ環及びその誘導体が特に好ましい。

【0055】上記のものを含め三重項発光材料の例としては例えば、特開2001-181616号、特開2001-181616号、特開2001-181617号、特開2001-247859号、特願2000-89274号、特開2002-203679号、特開2002-241751号、特開2002-117978号、特開2002-170684号、特願2001-239281号、特願2001-2

48165号、WOOO/57676号、WOOO/70655号、WOO1/39234A2号、WOO1/41512A1号、US6097147A号記載の化合物などが挙げられる。

【0056】本発明の有機電界発光素子の発光スペクト ルは特に限定されるものではないが、フルカラーディス プレイなどへの適用を考慮した場合、発光極大波長を5 00 n m以下(青色の発光)であることが好ましい。発 光材料としては、最低励起三重項エネルギー準位(Tu レベル) が45kcal/mol(188kJ/mo 1)以上90kcal/mo1(378kJ/mo1) 以下であることが好ましく、55kca1/mo1(2 30kJ/mo1)以上85kca1/mo1(356 k J/mo1)以下であることがより好ましく、青色発 光素子とするために、63kcal/mol(264k J/mol)以上81kcal/mol(340kJ/ mol)以下であることが特に好ましい。さらに、素子 の発光効率を高めるために、発光材料の燐光の量子収率 は、好ましくは0.5以上(より好ましくは0.6以 上、特に好ましくは0.7以上)である。

【0057】本発明における好ましい発光材料としては、以下の具体例が挙げられる。

【0058】 【化13】

(D-1) 
$$(D-2)$$
  $(D-2)$   $(D-2)$   $(D-3)$   $(D-4)$   $(D-4)$   $(D-4)$   $(D-5)$   $(D-5)$   $(D-6)$   $(D-6)$   $(D-7)$   $(D-7)$ 

【0059】

$$(D-10) \qquad (D-11) \qquad (D-12) \qquad (D-13)$$

$$(D-12) \qquad (D-13)$$

$$(D-13) \qquad (D-13)$$

$$(D-14) \qquad (D-15) \qquad (D-15) \qquad (D-16) \qquad (D-17) \qquad (D-17) \qquad (D-18) \qquad ($$

【0060】次にホスト材料について説明する。ホスト 材料は、発光材料とともに発光層を形成するものであ り、電界印加時に陽極または正孔注入層、正孔輸送層か ら正孔を発光層に注入し、陰極または電子注入層、電子 輸送層から電子を発光層に注入する機能を有し、さらに 注入された電荷を発光層内で移動させ、正孔と電子の再 結合させ、生成した電子・正孔対の励起子を発光材料に 引き渡し発光材料を発光させる機能を有するものであ る。ホスト材料としては上記機能を有するものであれば 特に限定されない。本発明の有機電界発光素子にホスト 材料として用いられる化合物としては、例えばカルバゾ ール、インドール、ピロール、ピラゾール、イミダゾー ル、ベンズイミダゾール、ピラゾロピリジン、イミダゾ ロピリジン、イミダゾロピラジン、ベンズイミダゾー ル、ベンゾオキサゾール、ベンゾイミダゾール、ベンゾ チアゾールのような含窒素ヘテロ環化合物、チオフェ ン、ベンズチオフェンのような含イオウヘテロ環化合 物、スチリルベンゼン、ポリフェニル、ジフェニルブタ ジエン、フルオレン、芳香族縮環炭素環化合物(ナフタ レン、アントラセン、ピレン等)、テトラフェニルブタ ジエン、ナフタルイミド、クマリン、ペリレン、ペリノ ン、オキサジアゾール、アルダジン、ピラリジン、シク ロペンタジエン、ビススチリルアントラセン、キナクリ ドン、ピロロピリジン、チアジアゾロピリジン、スチリ ルアミン、芳香族ジメチリディン化合物、トリアリール アミン化合物、ジアルキルアニリン化合物のようなアニ リン誘導体、8-キノリノール誘導体の金属錯体、有機 金属錯体や希土類錯体に代表される各種金属錯体や上記

の誘導体などが挙げられる。

【0061】ホスト材料自体が、生成した励起子により発光してもよい。その場合、素子全体からの所望の発光域により、許容できる発光域は変わるが、通常、ホスト材料単独膜として紫外から緑色域に発光を有するものが好ましい。そのようなホスト材料としては、好ましくはカルバゾール、インドール、ピロール、ベンズイミダゾール、プリン、ベンズイミダゾール、ピラゾロピリジン、イミダゾロピリジン、イミダゾロピリジン、イミダゾロピリジン、イミダゾロピリジン、オミダゾロピリジンなどの含窒素へテロ環、二置換アニリン化合物、チオフェン化合物、ポリフェニル及びこれらの誘導体もしくは有機金属錯体等が挙げられる。ホスト材料として更に好ましくは特開2002-100476号記載の材料が挙げられる。また、本発明では前記したように、ホスト材料と発光材料からなる発光層は導電性高分子を含有する層と隣接している。

【0062】発光層を形成する材料のうち発光材料を除いた材料(ホスト材料)の励起三重項エネルギー準位( $T_1$ レベル)は、発光材料の $T_1$ レベルより大きいものが望まれる。ホスト材料の $T_1$ レベルを発光材料の $T_1$ レベルより大きくすることで、ホスト材料にて生成された励起子が発光材料へ移動し、発光を起こす確率が高くなり、発光効率が向上する。したがって、発光材料を除いた発光層として $T_1$ レベルは、45kcal/mol(378kJ/mol)以上90kcal/mol(378kJ/mol)以上であることが好ましく、55kcal/mol(356kJ/mol)以下であることがよ

り好ましい。特に青色発光素子の場合は、好ましくは6 4 k c a 1 / m o 1 (2 6 8 k J / m o 1)以上8 2 k c a 1 / m o 1 (3 4 4 k J / m o 1)以下(下限値としては、より好ましくは6 5 k c a 1 / m o 1 (2 7 2 k J / m o 1)、特に好ましくは6 7 k c a 1 / m o 1 (2 8 0 k J / m o 1))以上である。

【0063】本発明における好ましいホスト材料としては、以下の具体例が挙げられる。

[0064]

【化15】

[0065]

【化16】

$$(H-4) \bigcirc N - \bigcirc CH_2 - \bigcirc N$$

【0066】 【化17】

[0067]

【化18】

(H-13) 
$$CH_3$$
  $N \cap CH_3$   $N \cap CH$ 

【0068】本発明の有機電界発光素子の発光層は、蒸着法により製膜される。蒸着法により製膜することで、 塗布法などに比べ高効率発光が可能である。蒸着法としては、抵抗加熱蒸着法などが挙げられる。

【0069】発光層は、前述の発光材料およびホスト材料からなるが、さらに後述の電子輸送層に例示する電子輸送材料を含有してもよい。発光層の膜厚は特に限定されるものではないが、通常 $1\,\mathrm{nm}\sim5\,\mu\mathrm{m}$ の範囲のものが好ましく、より好ましくは $5\,\mathrm{nm}\sim1\,\mu\mathrm{m}$ であり、更に好ましくは $1\,0\,\mathrm{nm}\sim5\,0\,0\,\mathrm{nm}$ である。

【0070】次に、本発明の有機電界発光素子における、導電性高分子を含む隣接層、発光層以外の層に関して説明する。陽極は正孔注入層、正孔輸送層、発光層などに正孔を供給するものであり、金属、合金、金属酸化物、電気伝導性化合物、またはこれらの混合物などを用いることができ、好ましくは仕事関数が4eV以上の材料である。具体例としては酸化スズ、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化インジウムスズ(ITO)などの導電性金属酸化物、あるいは金、銀、クロム、ニッケル等の金属、さらにこれらの金属と導電性金属酸化物との混合物、または積層物、ヨウ化銅、硫化銅などの無機導電性物質、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピロールなどの有機導電性材料、およびこれらとITOとの積層物などが挙げられ、好ましくは、導電性金属酸化物であり、特に、生産性、高伝導性、透明性などの観点からI

TOが好ましい。陽極の膜厚は材料により適宜選択可能であるが、通常 $10nm\sim5\mu$ mの範囲のものが好ましく、より好ましくは $50nm\sim1\mu$ mであり、更に好ましくは $100nm\sim500$ nmである。

【0071】陽極は通常、ソーダライムガラス、無アルカリガラス、透明樹脂を基板として用い、該基板上に層形成したものが用いられる。基板として、ガラスを用いる場合、その材質については、ガラスからの溶出イオンを少なくするため、無アルカリガラスを用いることが好ましい。また、ソーダライムガラスを用いる場合、シリカなどのバリアコートを施したものを使用することが好ましい。基板の厚みは機械的強度を保つのに充分な厚みであれば特に制限はないが、ガラスを用いる場合には、通常0.2mm以上、好ましくは0.7mm以上のものを用いる。

【0072】陽極の作製には材料によって種々の方法が 用いられるが、例えばITOの場合、電子ビーム法、スパッタリング法、抵抗加熱蒸着法、化学反応法(ゾルー ゲル法など)、ITOの分散物の塗布などの方法で膜形 成される。陽極は洗浄その他の処理により、素子の駆動 電圧を下げたり、発光効率を高めることも可能である。 例えばITOの場合、UVーオゾン処理、プラズマ処理 などが効果的である。

【0073】陰極は電子注入層、電子輸送層、発光層などに電子を供給するものであり、電子注入層、電子輸送

層、発光層などの陰極と隣接する層との密着性やイオン 化ポテンシャル、安定性などを考慮して選ばれる。陰極 の材料としては金属、合金、金属酸化物、電気伝導性化 合物、またはこれらの混合物を用いることができ、具体 例としてはアルカリ金属(例えばLi、Na、K、Cs など)またはそのフッ化物、その酸化物、アルカリ土類 金属(例えばMg、Caなど)またはそのフッ化物、そ の酸化物、金、銀、鉛、アルミニウム、ナトリウムーカ リウム合金、またはそれらの混合金属、リチウムーアル ミニウム合金、またはそれらの混合金属、マグネシウム 銀合金、またはそれらの混合金属、インジウム、イッ テルビウムなどの希土類金属が挙げられ、好ましくは仕 事関数が4 e V以下の材料であり、より好ましくはアル ミニウム、リチウムーアルミニウム合金、またはそれら の混合金属、マグネシウムー銀合金、またはそれらの混 合金属などである。陰極の膜厚は材料により適宜選択可 能であるが、通常10nm~5μmの範囲のものが好ま しく、より好ましくは50 nm~1 μmであり、更に好 ましくは100nm~1μmである。

【0074】陰極の作製には電子ビーム法、スパッタリング法、抵抗加熱蒸着法、コーティング法などの方法が用いられ、金属を単体で蒸着することも、二成分以上を同時に蒸着することもできる。さらに、複数の金属を同時に蒸着して合金電極を形成することも可能であり、またあらかじめ調整した合金を蒸着させても良い。陽極および陰極のシート抵抗は低い方が好ましく、数百Ω/□以下が好ましい。

【0075】正孔注入層、正孔輸送層の材料は、陽極か ら正孔を注入する機能、正孔を輸送する機能、陰極から 注入された電子を障壁する機能のいずれかを有している ものであればよい。その具体例としては、カルバゾー ル、イミダゾール、トリアゾール、オキサゾール、オキ サジアゾール、ポリアリールアルカン、ピラゾリン、ピ ラゾロン、フェニレンジアミン、アリールアミン、アミ ノ置換カルコン、スチリルアントラセン、フルオレノ ン、ヒドラゾン、スチルベン、シラザン、芳香族第三級 アミン化合物、スチリルアミン、芳香族ジメチリディン 化合物、ポルフィリン系化合物、ポリシラン系化合物、 ポリ(Nービニルカルバゾール)、アニリン系共重合 体、チオフェンオリゴマーおよびポリマー、ポリチオフ ェンなどの導電性高分子オリゴマーおよびポリマー、カ ーボン膜や上記の誘導体などが挙げられる。正孔注入 層、正孔輸送層の膜厚は材質により特に限定されるもの ではないが、通常1nm~5µmの範囲のものが好まし く、より好ましくは5nm~1μmであり、更に好まし くは10nm~500nmである。正孔注入層、正孔輸 送層は上述した材料の1種または2種以上からなる単層 構造であってもよいし、同一組成または異種組成の複数 層からなる多層構造であってもよい。

【0076】正孔注入層、正孔輸送層の形成方法として

は、真空蒸着法やLB法、インクジェット法、印刷法、 転写法、電子写真法、前記正孔注入材料、正孔輸送材料 を溶媒に溶解、または分散させてコーティングする方法 (スピンコート法、キャスト法、ディップコート法な ど)が用いられる。コーティング法の場合、樹脂成分と 共に溶解または分散することができ、樹脂成分としては 例えば、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリエステル、ポリ スルホン、ポリフェニレンオキシド、ポリブタジエン、 ポリ(Nービニルカルバゾール)、炭化水素樹脂、ケトン樹脂、フェノキシ樹脂、ポリアミド、エチルセルロー ス、酢酸ビニル、ABS樹脂、ポリウレタン、メラミン 樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、シリコン樹脂などが挙げられる。

【〇〇77】電子注入層、電子輸送層の材料は、陰極か ら電子を注入する機能、電子を輸送する機能、陽極から 注入され得た正孔を障壁する機能のいずれかを有してい るものであれば良い。その具体例としては、ヘテロ原子 を2つ以上含むヘテロ環骨格、オキサジアゾール、フル オレノン、アントラキノジメタン、アントロン、ジフェ ニルキノン、チオピランジオキシド、カルボジイミド、 フルオレニリデンメタン、ジスチリルピラジン、ナフタ レンペリレンなどの芳香環テトラカルボン酸無水物、フ タロシアニン、8ーキノリノール誘導体の金属錯体やメ タルフタロシアニン、ベンゾオキサゾールやベンゾチア ゾールを配位子とする金属錯体に代表される各種金属錯 体や上記の誘導体などが挙げられる。 ヘテロ原子を2つ 以上含むヘテロ環骨格としては、少なくとも2つ以上の ヘテロ原子を含むヘテロ環化合物としては炭素原子、水 素原子以外の原子を基本骨格内に2つ以上有する化合物 であり、単環または縮環であってもよい。ヘテロ環骨格 としては、好ましくはN、O、S原子から選ばれる原子 を2つ以上有するものであり、更に好ましくは少なくと も一つN原子を骨格内に有する芳香族へテロ環であり、 特に好ましくはN原子を骨格内に2つ以上有する芳香族 ヘテロ環である。また、ヘテロ原子は縮合位置にあって も、非縮合位置にあってもよい。例えばピラゾール、イ ミダゾール、オキサゾール、チアゾール、トリアゾー ル、オキサジアゾール、チアジアゾール、ピラジン、ピ リミジン、インダゾール、プリン、フタラジン、ナフチ リジン、キノキサリン、キナゾリン、シンノリン、プテ リジン、ペリミジン、フェナントロリン、ピロロイミダ ゾール、ピロロトリアゾール、ピラゾロイミダゾール、 ピラゾロトリアゾール、ピラゾロピリミジン、ピラゾロ トリアジン、イミダゾイミダゾール、イミダゾピリダジ ン、イミダゾピリジン、イミダゾピラジン、トリアゾロ ピリジン、ベンゾイミダゾール、ナフトイミダゾール、 ベンゾオキサゾール、ナフトオキサゾール、ベンゾチア ゾール、ナフトチアゾール、ベンゾトリアゾール、テト ラザインデン、トリアジンなどが挙げられる。中でも、

好ましくはトリアゾール、オキサジアゾール、チアジア ゾール、イミダゾピリダジン、イミダゾピリジン、イミ ダゾピラジン、ベンゾイミダゾール、ナフトイミダゾー ル、ベンゾオキサゾール、ナフトオキサゾール、ベンゾ チアゾール、ナフトチアゾール、トリアジンであり、よ り好ましくはイミダゾピリジン、イミダゾピラジン、ベ ンゾイミダゾール、ナフトイミダゾールであり、更に好 ましくはイミダゾピリジン、ベンゾイミダゾール、ナフ トイミダゾール、トリアジンである。

【0078】電子注入層、電子輸送層としては、特に好ましくは発光層を形成する材料より高い $T_1$ レベルを有する化合物からなることが、発光効率の点からは好ましい。そのため、電子輸送材料単独膜の $T_1$ レベルは、45kcal/mol(188kJ/mol)以下であることが好ましく、58kcal/mol)以下であることが好ましく、58kcal/mol(243kJ/mol)以下であることがより好ましい。特に青色発光素子の場合は、64kcal/mol(268kJ/mol)以上82kcal/mol(344kJ/mol)以下であることが好ましい。

【0079】本発明における好ましい電子輸送材料としては、以下の具体例が挙げられる。

【0080】 【化19】

【0081】 【化20】

【0082】 【化21】

【0083】電子注入層、電子輸送層の膜厚は特に限定されるものではないが、通常 $1 nm \sim 5 \mu m$ の範囲のものが好ましく、より好ましくは $5 nm \sim 1 \mu m$ であり、更に好ましくは $10 nm \sim 500 nm$ である。電子注入

層、電子輸送層は上述した材料の1種または2種以上からなる単層構造であってもよいし、同一組成または異種組成の複数層からなる多層構造であってもよい。電子注入層、電子輸送層の形成方法としては、真空蒸着法やLB法、インクジェット法、印刷法、転写法、電子写真法、前記電子注入材料、電子輸送材料を溶媒に溶解、または分散させてコーティングする方法(スピンコート法、キャスト法、ディップコート法など)が用いられる。コーティング法の場合、樹脂成分と共に溶解または分散することができ、樹脂成分としては例えば、正孔注入・輸送層の場合に例示したものが適用できる。

【0084】本発明の発光素子では、最表面に保護層を 設けてもよい。保護層の材料としては水分や酸素などの 素子劣化を促進するものが素子内に入る事を抑止する機 能を有しているものであれば良い。その具体例として は、In、Sn、Pb、Au、Cu、Ag、Al、T i、Niなどの金属、MgO、SiO、SiO、Al, O<sub>3</sub>, GeO, NiO, CaO, BaO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Y<sub>2</sub> O<sub>3</sub>、TiO<sub>2</sub>などの金属酸化物、SiNx、SiNxO yなどの窒化物、MgF<sub>2</sub>、LiF、AlF<sub>3</sub>、CaF<sub>2</sub> などの金属フッ化物、ポリエチレン、ポリプロピレン、 ポリメチルメタクリレート、ポリイミド、ポリウレア、 ポリテトラフルオロエチレン、ポリクロロトリフルオロ エチレン、ポリジクロロジフルオロエチレン、クロロト リフルオロエチレンとジクロロジフルオロエチレンの共 重合体、テトラフルオロエチレンと少なくとも1種のコ モノマーを含むモノマー混合物を共重合させて得られる 共重合体、共重合主鎖に環状構造を有する含フッ素共重 合体、吸水率1%以上の吸水性物質、吸水率0.1%以 下の防湿性物質などが挙げられる。

【0085】保護層の形成方法についても特に限定はなく、例えば真空蒸着法、スパッタリング法、反応性スパッタリング法、反応性スパッタリング法、MBE(分子線エピタキシー)法、クラスターイオンビーム法、イオンプレーティング法、プラズマ重合法(高周波励起イオンプレーティング法)、プラズマCVD法、レーザーCVD法、熱CVD法、ガスソースCVD法、コーティング法、インクジェット法、印刷法、転写法、電子写真法を適用できる。

#### [0086]

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明を具体的に説明 するが、本発明はこれにより限定されるものではない。 実施例1

25mm×25mm×0.7mmのガラス基板上にIT Oを150nmの厚さで製膜したもの(東京三容真空 (株)製)を透明支持基板とした。この透明支持基板を エッチング、洗浄後、隣接層を形成する導電性材料とし てBaytronP(PEDOT-PSS水分散物(ポリエチレンジオキシチオフェンーポリスチレンスルホン 酸ドープ体)/バイエル社製)を洗浄した基板上にスピ ンコートし(1000rpm、30秒)、150℃にて 1.5時間、真空乾燥した。隣接層の膜厚は50nmであった。この基板を蒸着装置に入れ、 $10^{-3}\sim10^{-4}$  P aの真空中で、基板温度室温の条件下、次に発光材料 (D-1)及びホスト材料 (H-1)をそれぞれ蒸着速度0.04nm/秒、0.4nm/秒で膜厚が36nmとなるように共蒸着し、発光層を形成した。さらに電子輸送材料 (E-1)を36nm蒸着し、有機薄膜上にパターニングしたマスク(発光面積が $4mm\times5mm$ となる)を装着し、フッ化リチウムを5nm蒸着した後、アルミニウムを50nmを蒸着し、引き続き素子を封止し EL素子を作製した(素子No.101)。

#### 【0087】実施例2

実施例1のBaytron Pの替わりに、同じく導電性材料であるTPDPES-TBPAをスピンコートした基板を蒸着装置に入れ、実施例1と同様の素子を作製した(素子No. 102)。

#### 【0088】実施例3

実施例 2の電子輸送材料(E-1)の替わりにBCPを 10nm、その上にA  $1q_3$ を30nm蒸着し、実施例 1と同様の方法でフッ化リチウム、アルミニウムを蒸着し、引き続き素子を封止しE L素子を作製した(素子N o. 103)。

#### 【0089】実施例4

実施例3の発光材料 (D-1) の替わりに  $Ir(ppy)_3$ を用い、ホスト材料として CBP を用いた素子を作製した(素子No.104)。

#### 【0090】比較例1

実施例2と同様にTPDPES-TBPAをスピンコートした基板を蒸着装置に入れ、 $10^{-3}\sim10^{-4}$ Paの真

空中で、基板温度室温の条件下、NPDを50nm蒸着した。次に発光材料  $Ir(ppy)_3$ 及びホスト材料 (CBP)をそれぞれ蒸着速度0.04nm/秒、0.4nm/秒で膜厚が36nmとなるように共蒸着し、発光層を形成した。さらにBCPを10nm、その上にA  $1q_3$ を30nm蒸着し、実施例1と同様の方法でフッ化リチウム、アルミニウムを蒸着し、引き続き素子を封止しEL素子を作製した(素子No.105)。

#### 【0091】比較例2

比較例1の発光材料を(D-1)に変更し同様の素子を作製した(素子No.106)。

#### 【0092】比較例3

比較例2のホスト材料を(H-1)に変更し同様の素子を作製した(素子No.107)

#### 【0093】比較例4

実施例1と同様にPEDOT-PSSをスピンコートした基板上にポリ(Nービニルカルバゾール)40mg、Ir(ppy) $_3$ 4mgをジクロロエタン2.5mlに溶解したものをスピンコートした。有機層の総膜厚は80nmであった。この基板を蒸着装置に入れ、 $_{10^{-3}}$ ~10-4Paの真空中で、基板温度室温の条件下、次にTAZを30nm、Alqを20nm蒸着し、実施例1と同様の方法でフッ化リチウム、アルミニウムを蒸着し、引き続き素子を封止しEL素子を作製した(素子No.108)。

【0094】以下に、本発明で用いた化合物の構造を示す。

[0095]

【化22】

【化23】

[0096]

【0097】次に以下のようにして作製した各素子を評価した。評価結果は表1に示す。東陽テクニカ製ソースメジャーユニット2400を用いて、ITOを陽極、アルミニウムを陰極として、直流定電流を有機薄膜に印加し、比較例および本発明の素子を発光させ、その輝度をトプコン社の輝度計BM-8、発光波長を浜松ホトニクス社製スペクトルアナライザーPMA-11を用いて測定し発光効率を求めた。また、素子を初期輝度100c

 $d/m^2$ で定電流駆動し、輝度半減時間を測定した。また、発光層から発光材料を除いた発光層の膜の最低励起三重項エネルギー準位を測定したところ、CBP462 kcal/mol(260kJ/mol)、H-1465 kcal/mol(272kJ/mol)であった。【0098】

【表1】

素子 No.	ELmax	色度(x,y)	外部量子 効率	駆動電圧 (5000cd/m²)	備考
101	488nm	(0.15,0.52)	22%	10.0V	本発明
102	486nm	(0.17,0.49)	20%	10.2V	本発明
103	484nm	(0.16,0.52)	15%	10.5V	本発明
104	517nm	(0.31,0.61)	17%	10.4V	本発明
105	516nm	(0.31,0.61)	16%	12.0V	比較例
106	485nm	(0.17,0.49)	4%	15.0V	比較例
107	485nm	(0.17,0.49)	5%	14.1V	比較例
108	514nm	(0.31,0.60)	2%	12.3V	比較例

【0099】ここで、色度とは、CIE表色系で定義された色度座標(x,y)の値を示す。

【0100】表1の結果から明らかなように発光層を塗布によって作製した素子(素子No.108)に比べ発光層を蒸着で作製した素子は発光効率に優れる。そして、高効率緑色発光素子(素子No.105)の発光材料を青色発光の短波発光材料(D-1)に変更すると、発光効率は大きく低下したが(素子No.106、107)、発光層に導電性材料層を隣接させ、高い最低励起三重項エネルギー準位を有するホスト材料を用いることにより、高効率発光できることが判る(素子No.101~103)。また、素子の発光輝度が5000cd/m²の時の駆動電圧を比較すると、本発明素子はほぼ10V程度であり比較素子に比べ低電圧駆動可能である。

本発明の高効率発光素子は耐久性にも優れ、初期輝度5000cd/m²で定電圧駆動を30分間行なった後の輝度維持率を比較すると、素子101/素子107=11倍、素子104/素子105=2倍であり、本発明の素子は高輝度発光時の耐久性に優れる。さらに本発明の素子は、比較例素子に比べ、高電圧、高電流下で素子の破壊が起らず、高輝度発光可能である。

# [0101]

【発明の効果】本発明により、発光層が蒸着法により形成され、特定の導電性(材料や物性)を隣接層を有するために、低電圧駆動可能で高効率発光する発光素子を得ることができる。特に三重項青色発光素子において高効率発光可能である。